

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаментальные исследования

<i>Мороча А.К., Рожков А.С.</i> Перенос электронов поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли.....	413
--	-----

Элементы интегральной электроники

<i>Юсипова Ю.А.</i> Анализ характеристик переключения ячеек памяти MRAM на основе материалов с одноосной анизотропией.....	421
--	-----

<i>Королёв М.А., Козлов А.В., Красюков А.Ю., Девликанова С.С.</i> Влияние концентрации примеси в пленке кремния на магниточувствительность КНИ полевых датчиков Холла.....	433
--	-----

<i>Соловьев А.В., Крупкина Т.Ю., Лагун А.М.</i> Использование системы TCAD для разработки маршрута изготовления комплементарных биполярных транзисторов в составе ОУ.....	440
---	-----

Схемотехника и проектирование

<i>Смолин А.А., Боруздина А.Б., Уланова А.В., Яненко А.В., Согоян А.В., Никифоров А.Ю., Телец В.А., Чумаков А.И., Шелепин Н.А.</i> Схемотехническое моделирование одиночных эффектов при воздействии тяжелых заряженных частиц в КМОП СБИС с суб-100-нм проектными нормами.....	447
---	-----

<i>Груздов В.В., Енишерлова К.Л., Колковский Ю.В., Давыдов Н.В., Капилин С.А.</i> Влияние параметров барьеров Шоттки AlGaN/GaN/SiC HEMT-транзисторов на фазовые шумы СВЧ-генераторов.....	460
---	-----

Информационно-коммуникационные технологии

Беляев И.В., Федоров А.Р., Гагарина Л.Г. Применение генетического алгоритма для повышения качества работы поисковых систем 471

Акиншин Н.С., Румянцев В.Л., Акиншин О.Н. Экспериментальная оценка информативности поляризационно-модулированных сигналов 478

Краткие сообщения

Козлов В.А., Чистюхин В.В. Аналитическое решение для подавления уровня интегральных боковых лепестков АКФ псевдослучайных последовательностей в РСА 487

Попов В.Д. Образование дефектов поверхности КМОП-структуры при облучении гамма-лучами и при повышенной температуре 491

Минаков Е.И., Калистратов Д.С. Применение векторных полей для анализа и прогнозирования движения в цифровых динамических видеоизображениях 494

Дуюнов Е.Д., Дуюнов Д.А., Теплова Я.О. Снижение торсионных вибраций в приводах установок для выращивания кремния 499

К сведению авторов 503